

## Транзисторы КТ926А, КТ926Б

## ЭТИКЕТКА

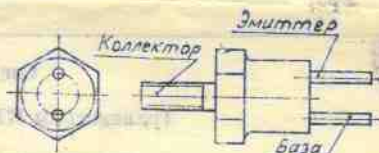
Кремниевые меза-планарные п-р-п мощные транзисторы КТ926А, КТ926Б в металлокерамическом корпусе предназначены для работы в импульсных модуляторах.

Вид климатического исполнения УХЛ 3.1, 5.1.

Корпус типа КТ-10, ГОСТ 18472-88

Масса транзистора не более 20 г

Условная точка на баллоне и (или) фланце расположена со стороны эмиттерного вывода



Основные электрические параметры Т корп. =  $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра (режим измерения), единицы измерения	Буквенное обозначен.	Норма	
		по мере	не более
Статический коэффициент передачи тока $I_{кэ} = 7 \text{ В}, I_{к} = 15 \text{ А}$ для КТ926А $I_{кэ} = 5 \text{ В}, I_{к} = 7 \text{ А}$ для КТ926Б	h21э	10	60
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В $I_{к} = 15 \text{ А}, I_{б} = 3 \text{ А}$ для КТ926А $I_{к} = 10 \text{ А}, I_{б} = 3 \text{ А}$ для КТ926Б	$I_{кэ} \text{ нас}$	—	2,5
Напряжение насыщения база-эмиттер, В $I_{к} = 15 \text{ А}, I_{б} = 1,5 \text{ А}$ для КТ926А $I_{к} = 10 \text{ А}, I_{б} = 1,5 \text{ А}$ для КТ926Б	$I_{бэ} \text{ нас}$	—	2,5
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА $I_{кэ} = 150 \text{ В}, R_{бэ} = 10 \text{ Ом}$	$I_{кэR}$	—	25
Обратный ток эмиттера, мА $I_{эб} = 5 \text{ В}$	$I_{эб0}$	—	300
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте $I_{кэ} = 10 \text{ В}, I_{к} = 1 \text{ А}, f = 30 \text{ МГц}$	(h21э)	1,7	—

Содержание драгметаллов в 1000 транзисторов:

Золота — 16,8391 г

Серебра — 196,7645 г

Содержание цветных металлов и их сплавов в 1000 шт. транзисторов

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса
Медь	МСб	10100 г

**Сведения о приемке**

Транзисторы КТ926А, КТ926Б соответствуют  
техническим условиям АА0.336.229ТУ

**Штамп ОТК**

**Указания по эксплуатации**

Указания по применению и эксплуатации транзисторов по ГОСТ 11630-84,  
ОСТ II 336.907.0-79.

Транзисторы необходимо применять с теплоотводами. Крепление транзисторов к теплоотводам должно обеспечивать надежный тепловой контакт. Для улучшения теплового контакта рекомендуется наносить на нижнее основание корпуса транзистора жидкость ПМС-100 по ГОСТ 13032-77 или другую теплопроводящую смазку.

При пайке выводов температура корпуса транзистора не должна превышать 125°C.

Т. 1500 З, 537-91